

**ACTIVE COMPONENTS FOR HYBRID CIRCUITS**  
**COMPOSANTS ACTIFS POUR CIRCUITS HYBRIDES**



**CB-166**  
(SOT-23)

**Planar silicon diodes**  
*Diodes planar au silicium*

Type Type	Marking Marquage	Pin conf. Brochage	$V_R$ (V)	$I_O$ (mA)	$V_F$ (V) / $I_F$ (mA)	$I_R$ ( $\mu$ A) / $V_R$ (V)	Equivalent Equivalence
		◆			max	max	
SD 914	D01	c	75	75	1 10	0,025 20	$\Delta$ 1N 914
SD 916	D20	c	75	75	1 10	0,025 20	$\Delta$ 1N 916

**Dual planar silicon diodes**  
*Doubles diodes planar au silicium*

Type Type	Marking Marquage	Pin conf. Brochage	$V_R$ (V)	$I_{FRM}$ (mA)	$V_F$ (mV) / $I_F$ (mA)	$I_R$ ( $\mu$ A) / $V_R$ (V)	Equivalent Equivalence
		◆			max	max	
BAW 56	A1 (1)	e	70	200	855 10	2,5 70	$\Delta$ 2 x 1N 4148
BAV 70	A4 (2)	f	70	200	855 10	5 70	$\Delta$ 2 x 1N 4148
BAV 99	A7 (3)	g	70	200	855 10	2,5 70	$\Delta$ 2 x 1N 4148

(1) Common anode      (2) Common cathode      (3) Serie diodes  
*Anodes communes      Cathodes communes      Diodes série*

**Variable capacitance diodes**  
*Diodes à capacité variable*

Type Type	Marking Marquage	Pin conf. Brochage	$V_R$ (V)	$I_{Fmax}$ (mA)	$I_R$ (nA) / $V_R$ (V)	C (pF) / $V_R$ (V)	$C(V_R=3V)$ $C(V_R=25V)$	Equivalent Equivalence
		◆			max	min max		
BBY 31	S1	c	28	20	100 28	1,8 - 2,8 25	typ 5	BB 105

◆ See page 206       $\Delta$  Devices under CCQ  
 Voir page 206      *Dispositifs soumis au Contrôle Centralisé de Qualité*